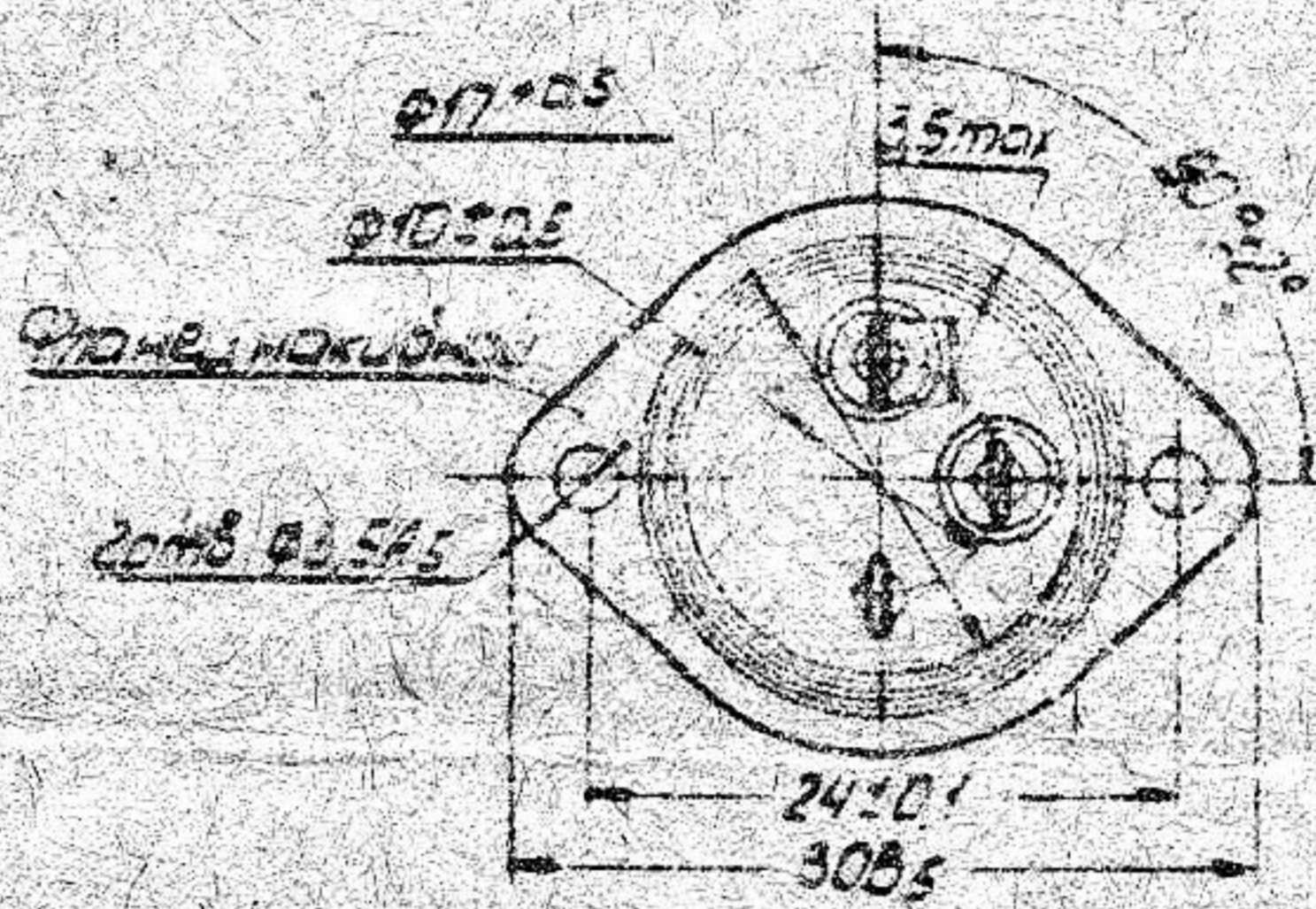
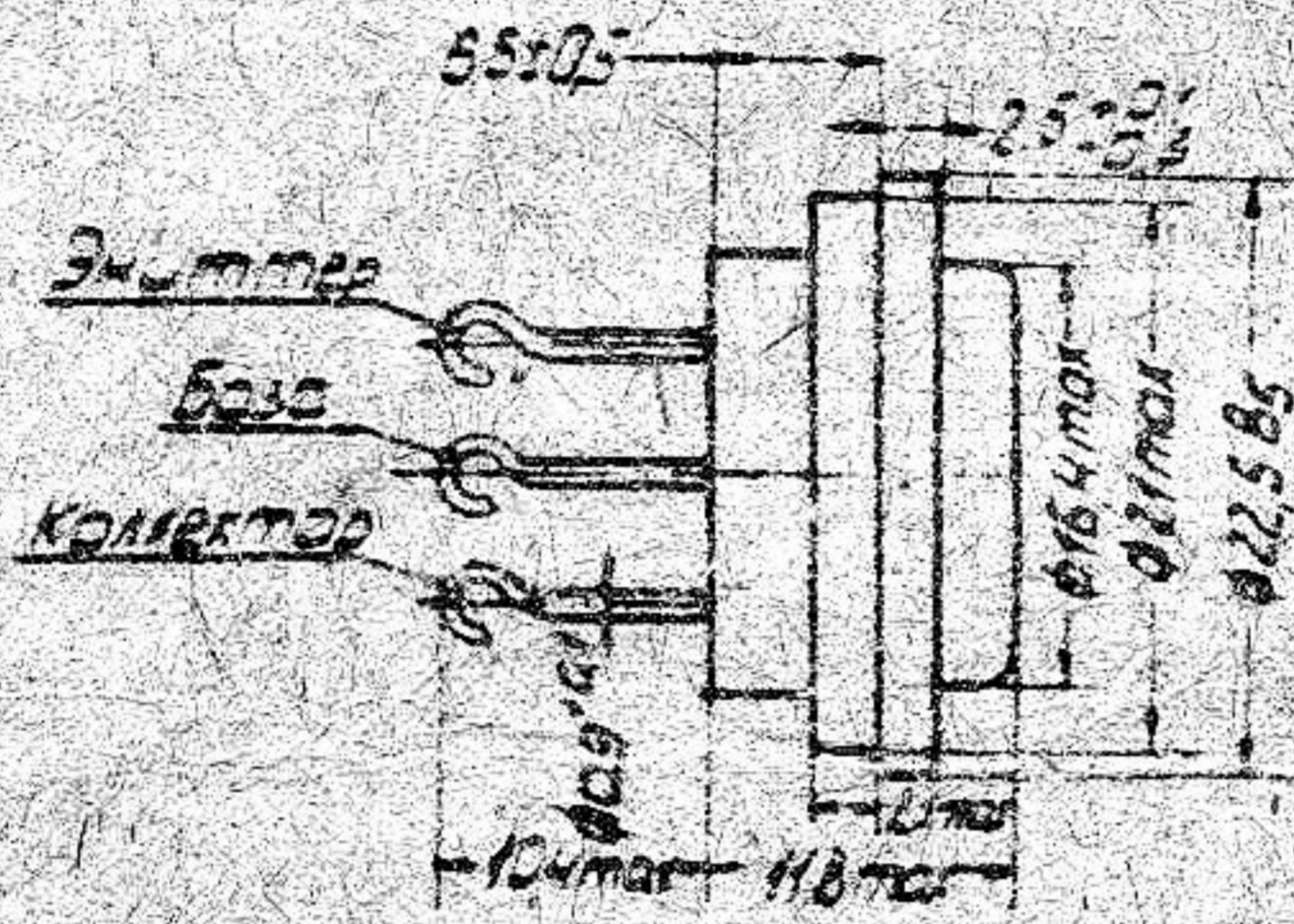


Германиевые плоскостные мощные транзисторы  
типов: МПЧА, МПЧБ, МПЧВ, МПЧГ, МПЧД

Технические условия ССЗ 365.005 ТУ  
Оборудованный чертеж ЦДБЗ.365.022 Г.



### Общие данные

Тип: германиевый р-п-р плоскостной мощный транзистор

Номинальная выходная мощность - 10 Вт

Конструкция транзистора герметична и обеспечивает:

- а) сохранность параметров при длительном воздействии вибрации с ускорением до 12g
- б) устойчивость к воздействию постоянных ускорений до 150g и ударных до 150g
- в) отсутствие резонансных частот и виброустойчивость в диапазоне 10-5000гц

### Электрические данные

Номенклатурное обозначение параметра	Обозначение	Единица измерения	Типы транзисторов				
			МПЧА	МПЧБ	МПЧВ	МПЧГ	МПЧД
1 Усиление по току при $I_k = 20$ $U_k = -10$ В, $f = 1$ кГц	$\beta$	мин макс	5	15	10	15	30
2 Индуктивность коллектора при $U_k = -10$ В	$L_k$	нГс макс	500	400	400	400	400
3 Усиление по мощности при $U_k = -25$ В, $I_k = 1$ А, $R_t = 15$ Ом $R_{th} = 25$ Ом	$K_n$	дБ мин макс	20	23	-	27	30
4 Тепловое сопротивление	$R_t$	$^{\circ}C/Вт$ макс	2	2	2	2	2
5 Предельная частота усиления (для схемы с общей базой)	$f_{0.1}$	кГц макс	150	150	150	150	150
6 Мощность, рассеиваемая коллектором (при температуре корпуса $+40^{\circ}C$ )	$P_{рас}$	Вт макс	20	25	25	25	25
7 Разность напряжений между коллектором и эмиттером при $I_k = 20$ , $U_b = 0.3$ В	$U_{ЭК}$	В макс	-	0.5	0.5	0.5	0.5

## Предельно допустимые эксплуатационные данные

№ п/п	Тип прибора	Максимальный коллекторный ток при $t_{\text{к}} \leq +40^{\circ}\text{C}$			Максимальный ток крайних токов коллектора $I_{\text{к}}^{\text{кр}}$	Максимальный ток базы $I_{\text{б}}$
		для схемы с общим эмиттером, В	для схемы с общим коллектором, В	для схемы с общим эмиттером, В		
		В	В	В		
1	МПЧА	60	50	40	5	1,2
2	МПЧБ	70	60	50	5	1,2
3	МПЧВ	40	35	25	5	1,2
4	МПЧГ	60	50	40	5	1,2
5	МПЧД	60	50	40	5	1,2

### Указания по эксплуатации

1. Для работы транзистор необходимо прочно припаять к теплоотводящей панели, обеспечить надежный тепловой контакт.

2. Допустимая мощность рассеивания определяется температурой корпуса прибора.

3. В процессе работы не разрешается превышать предельно допустимые значения параметров.

4. Пайка соединяющих проводов допускается только к крючкам выводов транзистора.

5. Допустимая мощность, рассеиваемая на коллекторе при температуре свыше  $+40^{\circ}\text{C}$  на корпусе, определяется по формуле

$$P_{\text{рас}} = \frac{90 - t_{\text{корп}}}{2^{\circ}\text{C}/\text{Вт}}$$

где  $P_{\text{рас}}$  - предельно-допустимая мощность рассеивания при температуре корпуса  $t^{\circ}\text{C}$ .

6. Предельная температура корпуса  $+70^{\circ}\text{C}$ .



Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

**9 МАЙ 1987**